

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】令和5年8月16日(2023.8.16)

【公開番号】特開2022-131086(P2022-131086A)
 【公開日】令和4年9月7日(2022.9.7)
 【年通号数】公開公報(特許)2022-165
 【出願番号】特願2021-29830(P2021-29830)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 2 1 / 2 0 (2 0 0 6 . 0 1)

10

C 3 0 B 3 3 / 0 6 (2 0 0 6 . 0 1)

C 3 0 B 2 9 / 0 6 (2 0 0 6 . 0 1)

C 2 3 C 1 6 / 3 4 (2 0 0 6 . 0 1)

H 0 1 L 2 1 / 2 0 5 (2 0 0 6 . 0 1)

H 0 1 L 2 1 / 0 2 (2 0 0 6 . 0 1)

【 F I 】

H 0 1 L 2 1 / 2 0

C 3 0 B 3 3 / 0 6

C 3 0 B 2 9 / 0 6 B

C 2 3 C 1 6 / 3 4

20

H 0 1 L 2 1 / 2 0 5

H 0 1 L 2 1 / 0 2 B

【手続補正書】

【提出日】令和5年8月7日(2023.8.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0033

【補正方法】変更

【補正の内容】

30

【0033】

図1に示す本発明の窒化物半導体基板20は、セラミックスウエーハ1と半導体層2からなる複合基板3と、例えばGaN HEMTが作製される窒化物半導体層4からなる。セラミックスウエーハ1は、窒化物セラミックスからなるコア(以下、セラミックスコアとも言う)5とセラミックスコア5を封入する封止層6からなる耐熱性支持基板7と、該耐熱性支持基板7上に設けられた平坦化層8からなる。なお、半導体層2はセラミックスウエーハ1側から順に、シリコン単結晶層9、炭化層10で構成されている。

40

50